







	<h2 style="color: red;">FQD5N60CTF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD5N60CTF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD5N60CTF.pdf 2.FQD5N60CTF.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N60CTF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2.8A (Tc) 2.5W (Ta), 49W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 49W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	670pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD5N60CTF ist neu im Original, Suche FQD5N60CTF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N60CTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N60CTF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD5N60CTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>
 <p>FQD5N60CTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p>FQD5N60C FAI FQD5N60C FAI</p>	 <p>FQD5N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK</p>	 <p>FQD5N60 FAIRCHILD FQD5N60 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD4N60C	↔ FQD4N60CTM	⇒ FQD4N65C	D FQD4P25TM	⇒ FQD4P25TM
⊕ FQD5N15TF	⊗ FQD5N15TF	D FQD5N15TM	⇒ FQD5N15TM	⇒ FQD5N20L
⊗ FQD5N20LTM	⊕ FQD5N20LTM	⊗ FQD5N20TF	↔ FQD5N20TF	⇒ FQD5N40TM
D FQD5N40TM	⊗ FQD5N50C	⊕ FQD5N50CTF	⊗ FQD5N50CTF	⇒ FQD5N50CTM
⇒ FQD5N50CTM	↔ FQD5N50CTM-NL	⊗ FQD5N50TF	⊕ FQD5N50TF	⇒ FQD5N60C
↔ FQD5N60CTF	⇒ FQD5N60CTM	D FQD5N60CTM	⊗ FQD5P10TF	⊕ FQD5P10TF
⊗ FQD5P10TM	D FQD5P10TM	⇒ FQD5P20TM	↔ FQD5P20TM	⇒ FQD630TF
⊕ FQD630TF	⊗ FQD630TM	↔ FQD630TM	⇒ FQD6N25TF	⇒ FQD6N25TF
⊗ FQD6N25TM	⊕ FQD6N25TM	⊗ FQD6N40C	D FQD6N40CTM	⇒ FQD6N40CTM
↔ FQD6N50CTF	⊗ FQD6N50CTF	⊕ FQD6N50CTM	⊗ FQD6N50CTM	⇒ FQD6N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited